

isc Silicon NPN Darlington Power Transistor

2SD1932

DESCRIPTION

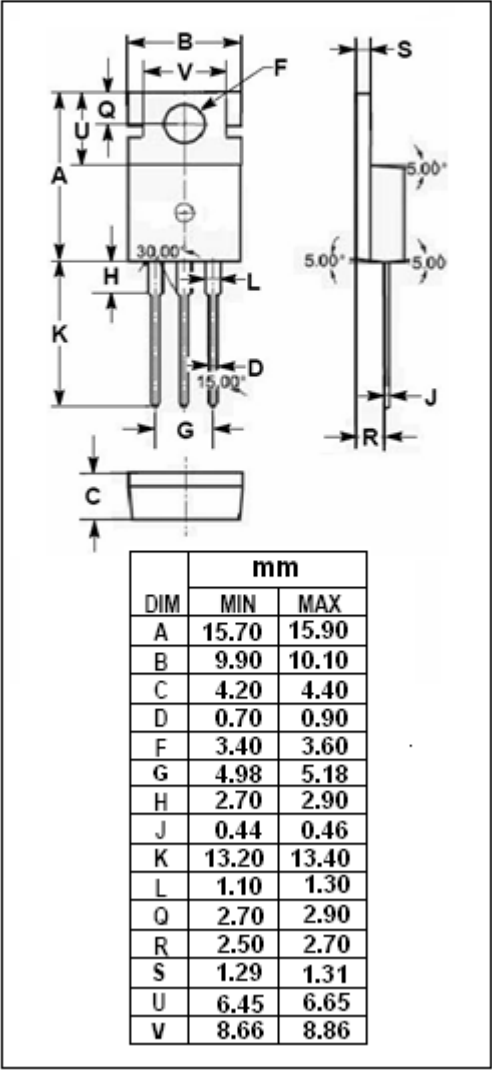
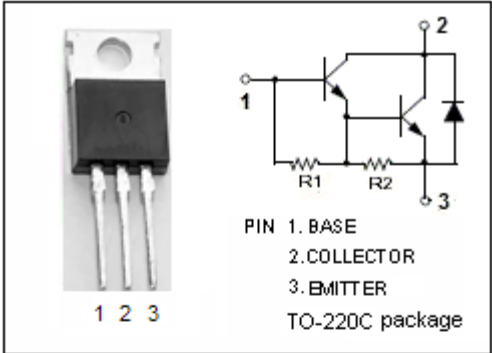
- Collector-Emitter Breakdown Voltage-
: $V_{(BR)CEO} = 80V(\text{Min})$
- High DC Current Gain-
: $h_{FE} = 1000(\text{Min})@ (V_{CE} = 3V, I_C = 2A)$

APPLICATIONS

- Designed for power amplifier applications.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS($T_a=25^{\circ}C$)

SYMBOL	PARAMETER	VALUE	UNIT
V_{CBO}	Collector-Base Voltage	80	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage	80	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage	7	V
I_C	Collector Current-Continuous	4	A
I_{CM}	Collector Current-Peak	6	A
P_C	Collector Power Dissipation @ $T_a=25^{\circ}C$	2	W
	Collector Power Dissipation @ $T_c=25^{\circ}C$	35	
T_J	Junction Temperature	150	$^{\circ}C$
T_{stg}	Storage Temperature	-55~150	$^{\circ}C$



isc Silicon NPN Darlington Power Transistor**2SD1932****ELECTRICAL CHARACTERISTICS****T_j=25°C unless otherwise specified**

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP.	MAX	UNIT
V _{(BR)CEO}	Collector-Emitter Breakdown Voltage	I _C = 1mA; I _B = 0	80			V
V _{(BR)CBO}	Collector-Base Breakdown Voltage	I _C = 50 μ A; I _E = 0	80			V
V _{CE(sat)}	Collector-Emitter Saturation Voltage	I _C = 2A; I _B = 4mA			1.5	V
I _{CBO}	Collector Cutoff Current	V _{CB} = 80V; I _E = 0			100	μ A
I _{EBO}	Emitter Cutoff Current	V _{EB} = 5V; I _C = 0			3	mA
h _{FE}	DC Current Gain	I _C = 2A; V _{CE} = 3V	1000		10000	
C _{OB}	Output Capacitance	I _E = 0; V _{CB} = 10V; f _{test} = 1MHz		35		pF
f _T	Current-Gain—Bandwidth Product	I _E = -0.2A; V _{CE} = 5V; f _{test} = 10MHz		40		MHz



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331